### ЛИТЕРАТУРА

- Giles C. H., MacEwan T. H., Nakhwa S. N., Smith D.//J. Chem. Soc. 1960. N 10. P. 3973.
  Сенаторова Н. Р., Рыжиков Б. Д.//Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1988. 29, № 1. С. 43.
  Де Бур Я. Х. Динамический характер адсорбщии. М., 1976.
  К. И. С. И. С. К. А. С. И. С. К. И. К. И. С. К. И. К. И. С. К. И. К.
- Кауль С. И., Сенаторов П. К.//Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1990. 31, 4 № 6. C. 37.
- [5] Шлезингер М., Клафтер Дж.//Фракталы в физике: Тр. VI Междунар. симп. по фракталам в физике. Триест, Италия, 9-12 июля 1985 г. М., 1988. C. 553.
- [6] Иваньян Л. И., Левшин Л. В., Рыжиков Б. Д.//Вестн. Моск. ун-та. Физ-Астрон, 1995, 36, № 1. С. 32.

Поступила в редакцию 29.07.94

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1995, Т. 36, № 1

## ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

УДК 534.2

84

### ФОКУСИРОВКА ФОНОНОВ В ПАРАТЕЛЛУРИТЕ

#### К. Н. Баранский, Л. Н. Мамина, И. В. Шляхов

(кафедра физики полимеров и кристаллов)

Определены направления фокусировки и дефокусировки фононов в кристалле парателлурита. На равномерных сетках направлений волновых нормалей отображены угловые положения соответствующих им лучей трех акустических мод. Установлена связь концентрации лучей с экстремумами групповой и фазовой скоростей необыкновенных волн в парателлурите.

Фокусировкой фононов принято называть концентрацию лучей (s) и энергии необыкновенных акустических волн около некоторых направлений в кристалле [1, 2]. Направления фокусировки фононов определяются особенностями поверхностей фазовых (V) и групповых (S) скоростей кристалла, образованных их векторами, построенными из начала кристаллофизической системы координат. Так, если точка касания этих поверхностей (V=S) соответствует их локальным максимумам, то к этому направлению отклоняются векторы лучей необыкновенных волн, имеющих различные направления нормалей п. Такие главные направления фокусировки особенно удобны для возбуждения коллимированных групп акустических волн, так как по ним распространяются обыкновенные волны (n=s) и они могут совпадать с юсями и плоскостями симметрии упругих свойств кристалла. Если же точка касания поверхностей соответствует минимуму одной и максимуму другой скорости, то ей соответствует направление дефокусировки фононов минимальной концентрации энергии акустических волн. Из окрестностей таких направлений волновых нормалей векторы лучей отклоняются к направлениям фокусировки фононов. Неоднородность распределения энергии волн особенно ярко выражена у кристаллов с сильной-анизотропией упругих свойств. К таким кристаллам относится кристалл парателлурита (ТеО<sub>2</sub>), широко применяемый в акустооптике [3, 4], где особенно важно получение хорошо коллимированных акустических волн. Этот пьезоэлектрический кристалл принадлежит к классу 422 и группе упругой симметрии 4/mmm, его упругие, пьезоэлектрические

и диэлектрические свойства подробно исследованы в ряде работ [5, 6]. В окрестности направлений координатных осей упругой симметрии второго порядка [100] и [010] фазовая скорость быстрых квазипоперечных (QFT) волн оказывается больше фазовой скорости квазипродольных (QL) волн. По этой причине три полости поверхности фазовых скоростей парателлурита нельзя отождествлять с волнами какого-то одного вида поляризации. Им принадлежат волны с минимальной, средней и максимальной скоростями (полости обозначаются M1, M2 и M3 соответственно [1, 5]).

Для определения направлений фокусировки нужно рассчитать н графически представить угловое распределение векторов лучей волн. соответствующих заданному равномерному распределению направлений волновых нормалей. С этой целью последовательно перебираются направления нормали, задаваемое углами ф и в, которые отсчитываются соответственно от положительных направлений осей ОХ, и OX<sub>3</sub>. Для каждого направления рассчитываются значения компонент векторов скоростей V, поляризаций р, групповых скоростей S и лучей s трех волн, распространяющихся по этому направлению. Направления векторов s определяются соответствующими им значениями углов  $\varphi_s$  и  $\theta_s$ . Значения углов  $\varphi$  и  $\theta$  перебираются с шагами в 1 и 5°. В сетке углов на рис. 1—3 угол φ отсчитывается против часовой стрелки от направления оси OX<sub>1</sub>, внешний сплошной круг служит его шкалой. Угол  $\theta$  отсчитывается линейно от центра по радиусу ( $R=\theta^0$ ). Центр сетки (0=0) соответствует оси ОХ3, продольной акустической оси кристалла. Внешний круг (0=90°) соответствует направлениям, лежащим в плоскости X<sub>1</sub>OX<sub>2</sub> упругой симметрии кристалла (001). Диаметры при Ф=0, 45, 90 и 135° включают направления, лежащие в плоскостях упругой симметрии (010), (110), (100) и (110). Их пересечения с плоскостью (001) — оси упругой симметрии второго порядка. По всем осям распространяются обыкновенные продольные (L) и поперечные (T) волны. В плоскостях симметрии распространяются T-волны, поляризованные перпендикулярно к ним, и квазипоперечные (QT) и квазипродольные (QL) волны, поляризованные в этих плоскостях. Лучи необыкновенных волн, распространяющихся в плоскости симметрии, отклоняются от своих нормалей, оставаясь в этой же плоскости.

На рис. 1, 2 и 3 точками отображены угловые распределения векторов лучей волн, принадлежащих к трем полостям: *M*1, *M*2 и *M*3 поверхности фазовых скоростей V парателлурита. Области сгущения точек соответствуют направлениям фокусировки фононов, к которым отклоняются лучи из областей дефокусировки.

На рис. 1 ось  $OX_3$  — главное направление фокусировки медленных поперечных (ST) и квазипоперечных (QST) волн, ему соответствуют акустическая ось, точка касания и локальный максимум поверхностей скоростей V и S. Четырехугольные контуры, образованные лучами и соответствующие нормалям с  $\theta$ =const, прерываются линиями фокусировки фононов, ограничивающими секторы дефокусировки. В плоскости (001) не отклоненные от нормалей лучи обыкновенных ST-волн, поляризованных по оси OX<sub>3</sub>, образуют дуги в окрестностях осей OX<sub>1</sub> и OX<sub>2</sub>. Лучи в плоскостях симметрии (110) и (110) отклоняются к оси OX<sub>3</sub> и осям [110] и [110].

На рис. 2 лучи QFT-волн расходятся из окрестности оси OX<sub>3</sub>, образуя область дефокусировки. Они описывают сложные контуры с завитками в окрестностях плоскостей симметрии (010) и (100). В результате образуется четырехугольная область фокусировки фононов.



В плоскости (001) лучи обыкновенных *FT*-волн образуют дуги в окрестностях осей [110] и [110], дополняющие дуги обыкновенных волн *ST* той же поляризации на рис. 1. В этих направлениях концентрация лучей существенно-выше, чем в областях дефокусировки фононов, и они удобны для возбуждения коллимированных волн.

На рис. З распределение лучей L- и QL-воли полости МЗ образу-



Рис. 3

ет главное направление фокусировки по оси  $OX_3$  и в плоскостях (110) и (110). Именно эти направления распространения *L*- и *QL*-волн и используются в акустооптике. В интервалах углов  $70^\circ < \theta < 110^\circ$  и  $-8^\circ < < \varphi < 8^\circ$  распространяются *QFT*-волны. Области дефокусировки этой полости довольно общирны.

Для эффективного использования явления фокусировки необходимо возбуждать расходящиеся волны, лучи которых фокусируются в избранном направлении. Это может осуществляться как путем уменьшения размеров пьезопреобразователя, что ведет к увеличению дифракционной расходимости волн, так и путем использования поверхностей специальной формы, обеспечивающих фокусировку волн. В направлениях фокусировки фононов возбуждение воли с вогнутой поверхности может привести как к коллимированию, так и к образованию каустики лучей. Условия пьезоэлектрического возбуждения парателлурита, обладающего поперечным пьезоэффектом, приводят к необходимости использования преобразователей на основе более эффективных пьезоэлектриков. Преобразователи в виде пленок пьезополупроводников на изогнутых поверхностях успешно используются для фокусировки гиперзвуковых волн в рубине [7].

87

# ЛИТЕРАТУРА

- Сиротин Ю. И., Шаскольская М. П. Основы кристаллофизики. М., 1975.
  Еvery А. G., Sachse W., Kim K. Y., Thompson M. O.//Phys Rev. Lett. 1990. 65, N 12. P. 1446.
  Voloshinov V. B.//Opt. Engineering. 1992. 31. P. 2089.
  Воронова М. А., Парыгин В. Н.//Вестн. Моск. ук-та. Физ. Астрон. 1988. 29, № 6. С. 27.
  Оhmachi Y., Uchida N.//J. Appl. Phys. 1969. 40. Р. 4692.
  Писаревский Ю. В., Сильвестрова И. М., Воронков Е. В. и др.// //Кристаллография. 1987. 32. С. 257.
  Ганадольский Е. М.//Письма в ЖЭТФ. 1988. 47. С. 111. 1988. 48. С. 370.
- [7] Ганапольский Е. М.//Письма в ЖЭТФ. 1988. 47. С. 111; 1988. 48. С. 370.

Поступила в редакцию 06.06.94